

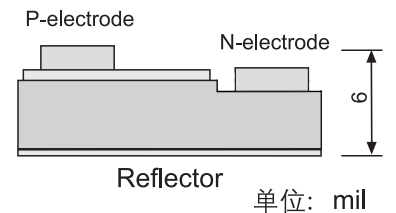
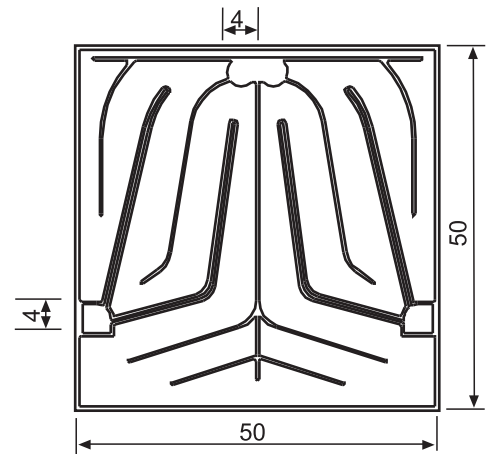


◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 低电流驱动, 损耗小
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好的一致性

◆ 物理参数:

P电极	金
N电极	金
芯片尺寸	50mil x 50mil (1270±15µm x 1270±15µm)
芯片厚度	6.0mil (150±10µm)
焊盘尺寸	4.0mil (100±10µm in diameter)



单位: mil

◆ 光电参数: ( $T_C=22^\circ\text{C}$ ,  $I_F=350\text{mA}$ )

产品型号	波长范围 ( $\lambda_D$ , nm)		工作电压 ( $V_F$ , V)	反向漏电流 ( $I_R$ , $\mu\text{A}$ ) @ $V_R=10\text{V}$	半波宽度 ( $\Delta\lambda$ , nm)	最大电流 ( $I_F$ , mA) DC
	Min	Max				
S-50ABMUP*-450E**	450	455	$\leq 3.6$	$\leq 2$	$\leq 35$	700
S-50ABMUP*-455E**	455	460				
S-50ABMUP*-460E**	460	465				
S-50ABMUP*-465E**	465	470				
S-50ABMUP*-470E**	470	475				

◆ 光强等级: ( $T_C=22^\circ\text{C}$ ,  $I_F=350\text{mA}$ )

等级	P05	P06	P07	P08	P09	P10	...
$I_V$ 范围(mcd)	2000-2400	2400-3000	3000-3600	3600-4400	4400-5200	5200-6200	...

◆ 其它说明

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下测试, 98%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于 $280^\circ\text{C}$ , 持续时间小于10秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差  $\pm 1.0\text{nm}$
- 可根据客户要求订做特殊规格的芯片